

.....oOo.....

CHƯƠNG 7: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT



Chương 7: **CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT**

I. Năng lượng bề mặt

II. Sự hấp phụ trên ranh giới dung dịch lỏng – khí

III. Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn

IV. Sự hấp phụ trên ranh giới lỏng – rắn



I. NĂNG LƯỢNG BỀ MẶT

1. Sức căng bề mặt:

Định nghĩa : là lực tác dụng trên một đơn vị độ dài trên bề mặt, tiếp tuyến với bề mặt, có khuynh hướng làm giảm diện tích bề mặt.

Kí hiệu: σ (dyn/cm).

Đổi đơn vị: $1 \text{ dyn/cm} = 10^{-3} \text{ N/m}$.



Công để tăng diện tích bề mặt
= độ tăng của năng lượng tự do bề mặt dE_s
= sự chênh lệch về thế năng giữa các phân tử trong pha thể tích và trong lớp bề mặt.

Năng lượng tự do bề mặt trên một đơn vị diện tích:

$$dE_s = \sigma \cdot dS$$

$$(1 \text{ erg} = 1 \text{ dyn} \cdot 1 \text{ cm}; 1 \text{ erg/cm}^2 = 1 \text{ dyn/cm})$$

Suy ra:

$$\sigma = \frac{E_s}{S}$$

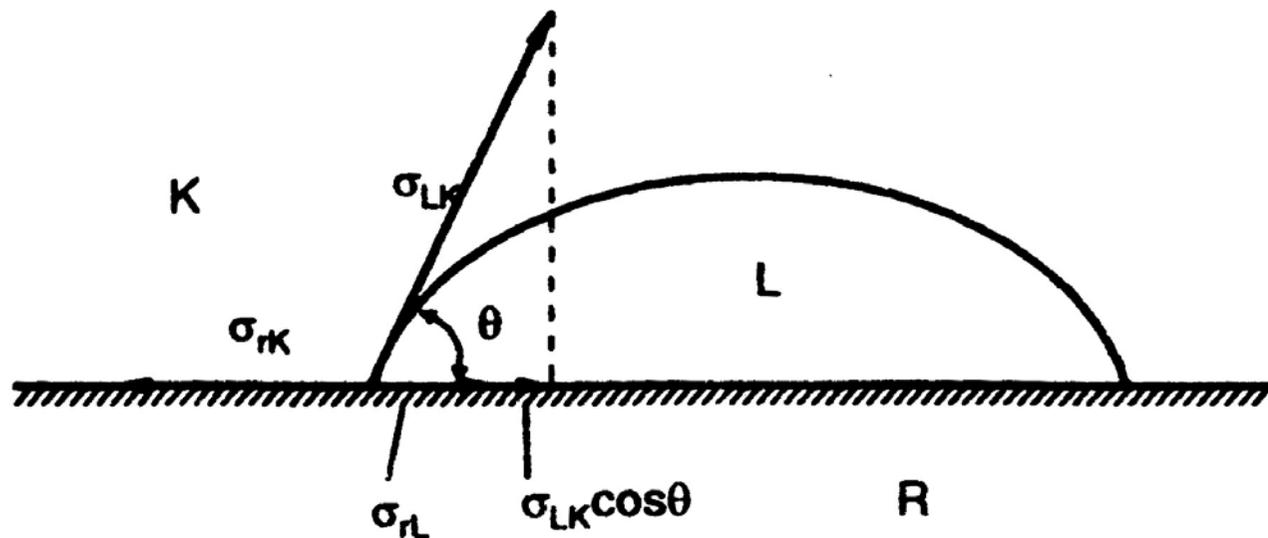
Sức căng bề mặt chính là năng lượng tự do trên một đơn vị diện tích bề mặt, cũng là công tạo nên 1 cm^2 bề mặt.

2. Hiện tượng dính ướt

Là sự phân bố bề mặt giữa 3 pha R – L – K sao cho năng lượng toàn phần bề mặt E_s là nhỏ nhất.

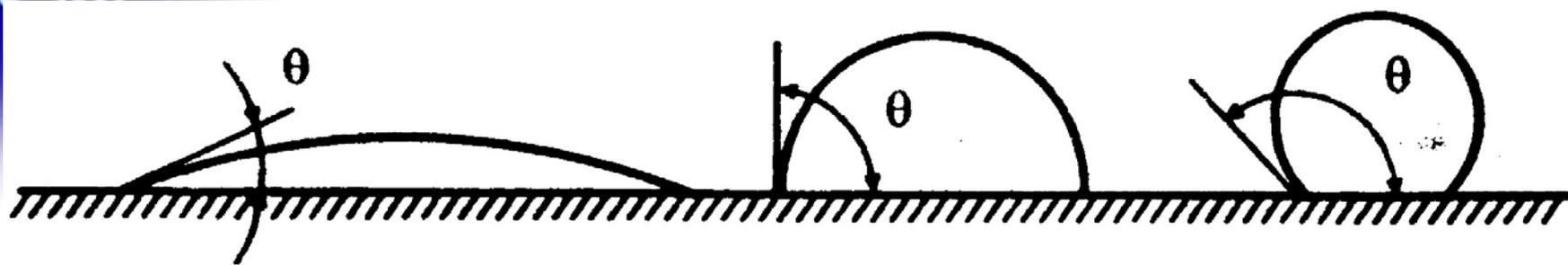
Các đại lượng đặc trưng: - Góc dính ướt: θ

- Độ dính ướt: $\cos\theta$



Định luật Young

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{rk} - \sigma_{rl}}{\sigma_{lk}}$$



a

b

c

Dính ướt

Không dính ướt

$$\sigma_{rk} > \sigma_{rl}$$

$$\cos\theta > 0$$

$$\theta < 90^\circ$$

$$\sigma_{rk} = \sigma_{rl}$$

$$\cos\theta = 0$$

$$\theta = 90^\circ$$

$$\sigma_{rk} < \sigma_{rl}$$

$$\cos\theta < 0$$

$$\theta > 90^\circ$$

Dính ướt toàn phần:

$$\sigma_{rk} > \sigma_{rl} + \sigma_{kl}$$

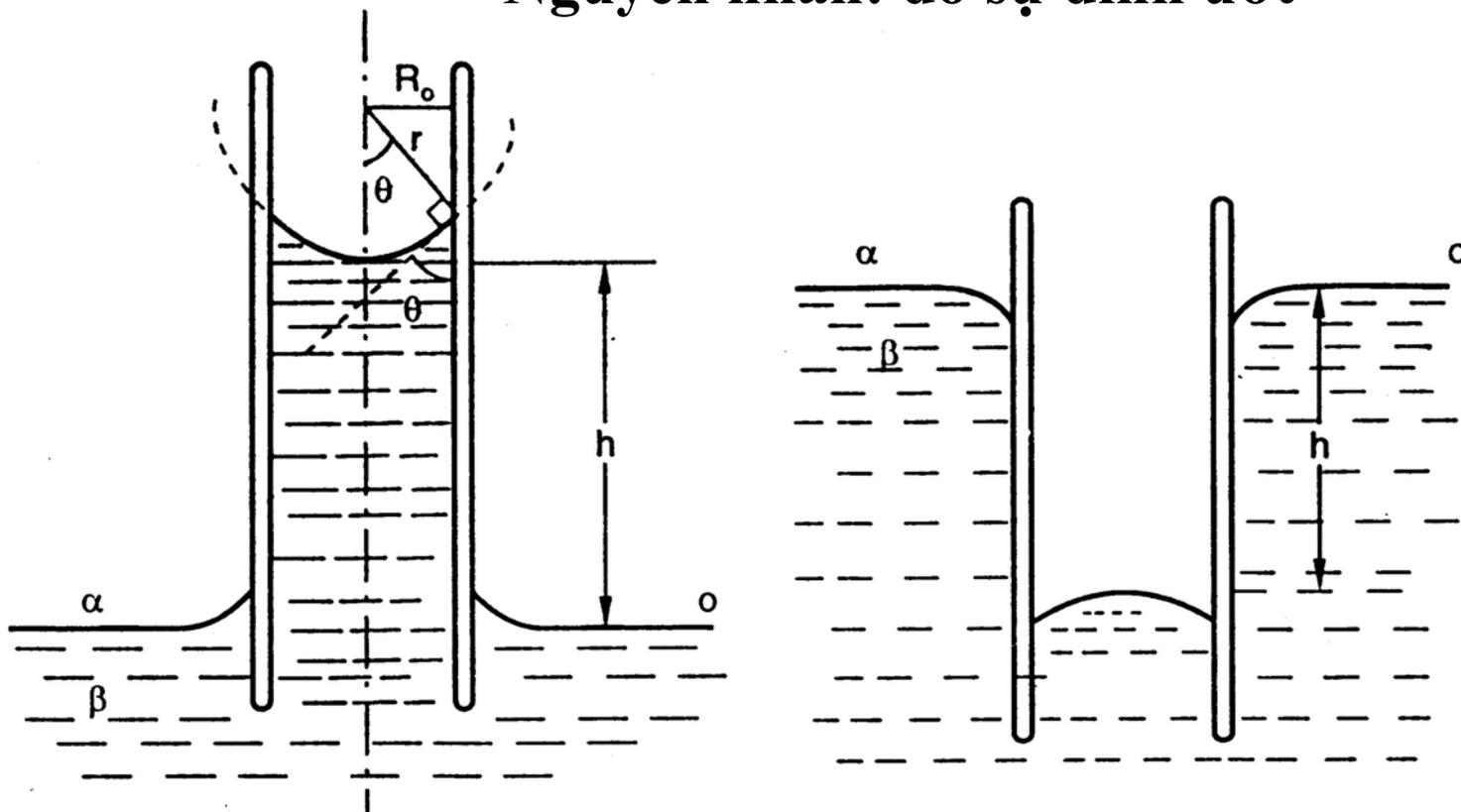
Không dính ướt toàn phần:

$$\sigma_{rl} > \sigma_{rk} + \sigma_{kl}$$

3. Hiện tượng mao dẫn

Là hiện tượng dâng lên hay tụt xuống của chất lỏng trong ống mao quản

Nguyên nhân: do sự dính ướt





Phương trình Young – Laplace:

Đối với mặt elip: $\Delta P = P^\alpha - P^\beta = \sigma \cdot \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$

Đối với mặt cầu: $\Delta P = P^\alpha - P^\beta = \frac{2 \cdot \sigma}{r}$

Quy ước:

- Mặt cong lồi : $r > 0 \Rightarrow \Delta P > 0 \Rightarrow P_L > P_K$
- Mặt cong lõm : $r < 0 \Rightarrow \Delta P < 0 \Rightarrow P_L < P_K$
- Mặt phẳng : $r = \infty \Rightarrow \Delta P = 0$



Phương trình Thompson - Kelvin :

Đối với giọt chất lỏng trong pha khí:

$$R.T . \ln \frac{P^r}{P^o} = \frac{2\sigma.\bar{V}}{r}$$

Đối với giọt chất lỏng trong pha lỏng:

$$R.T . \ln \frac{C^r}{C^o} = \frac{2\sigma.\bar{V}}{r'}$$

Quy ước:

- Mặt cong lồi : $r > 0 \Rightarrow P^r > P^o$
- Mặt cong lõm : $r < 0 \Rightarrow P^r < P^o$
- $r_1 < r_2 \Rightarrow P^{r1} > P^{r2}$

$$\sigma = \frac{1}{2} \cdot \frac{R_o \cdot g \cdot h \cdot (d^\beta - d^\alpha)}{\cos \theta}$$

4. Các phương pháp xác định sức căng bề mặt

1. Xác định sự biến đổi mực chất lỏng trong ống mao quản:

$$\sigma = \frac{1}{2} \cdot \frac{R_o \cdot g \cdot h \cdot (d^\beta - d^\alpha)}{\cos \theta}$$

2. Phương pháp cân giọt chất lỏng:

$$\sigma = \frac{V \cdot d \cdot g}{2 \cdot \pi \cdot R_o \cdot f^*}$$

V : thể tích giọt.

R₀: bán kính mao quản.

f*: hệ số hiệu chỉnh. Số tay.



SỰ HẤP PHỤ

Hấp phụ: là sự chất chứa, tập trung vật chất trên bề mặt phân chia pha.

Chất bị hấp phụ: là chất bị hút lên bề mặt phân chia pha

Chất hấp phụ: là chất trên bề mặt xảy sự hấp phụ.

Độ hấp phụ: là lượng chất bị hấp phụ trên bề mặt một đơn vị chất hấp phụ.

- x (mol/g)

- Γ (mol/m²)

$$\Gamma_i = \frac{n_i^S}{S}$$

II. SỰ HẤP PHỤ TRÊN BỀ MẶT LỎNG - KHÍ

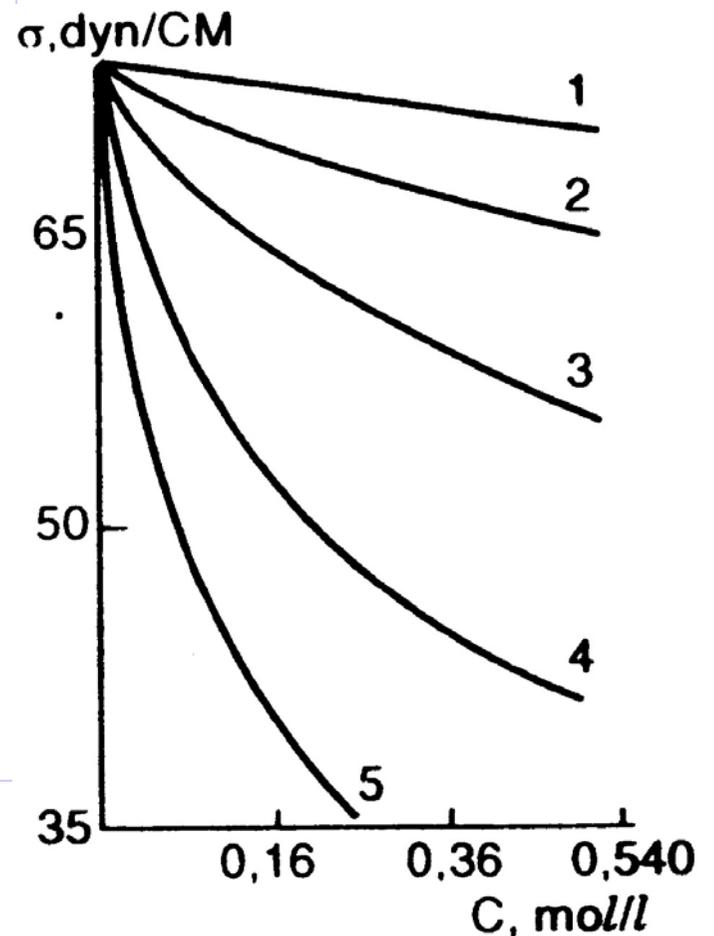
1. Chất hoạt động bề mặt:

Có thể xảy ra 2 trường hợp khi có chất tan trong dd

- **C tăng \rightarrow σ tăng :**

chất không hoạt động bề mặt

- **C tăng \rightarrow σ giảm :** chất HĐBM





2. Phương trình hấp phụ Gibbs

Xác định mối quan hệ giữa lượng chất bị hấp phụ trên bề mặt với nồng độ trong dd và sức căng bề mặt

$$d\sigma = -\sum_i \frac{n_i^S}{S} d\mu_i = -\sum_i \Gamma_i \cdot d\mu_i$$

- Với:
- μ_i : thế hóa học của cấu tử i
 - Γ_i : độ hấp phụ bề mặt của cấu tử



* Nếu hấp phụ hơi của cấu tử chất tan (2) trên dung môi (1), trong đó không có sự tan lẫn
(VD: hydrocarbon/H₂O)

$$\Gamma = -\frac{P}{R.T} \cdot \left(\frac{\partial \sigma}{\partial P} \right)_T$$

P : áp suất hơi bão hòa
của hơi/khí

* Nếu hấp phụ chất hòa tan trong dd lên bề mặt
pha lỏng:

$$\Gamma = -\frac{a}{RT} \cdot \left(\frac{d\sigma}{da} \right)_T$$

a: hoạt độ

Nếu dd loãng, thay a bằng

C

Độ hoạt động bề mặt

$$-\frac{d\sigma}{dC}, -\frac{d\sigma}{da}, -\frac{d\sigma}{dP} = G^* = \text{Độ hoạt động bề mặt} \\ = \text{Đại lượng Gibbs}$$

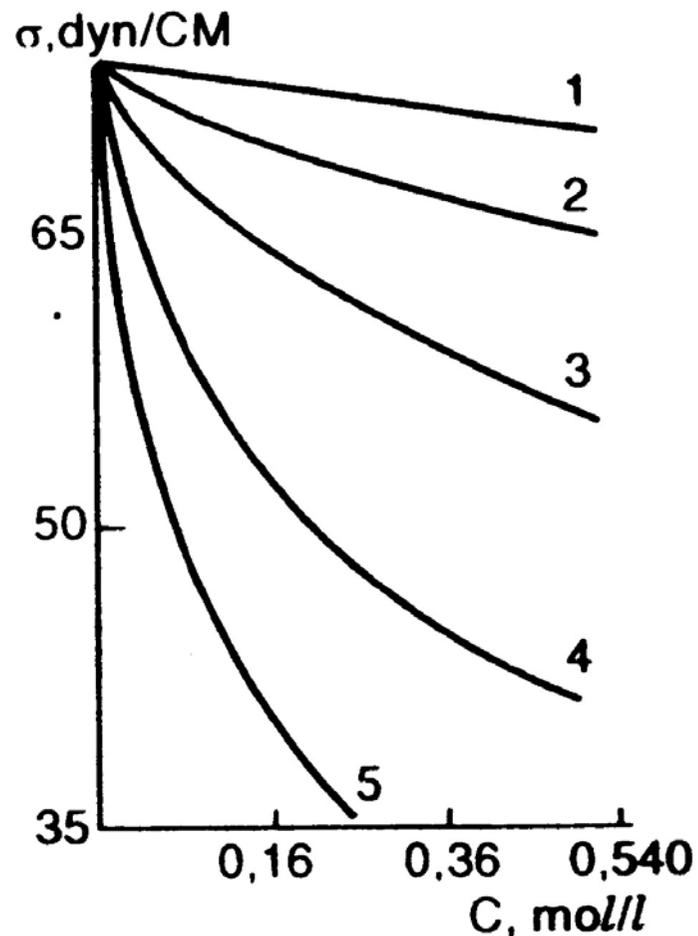
$$\Rightarrow \Gamma = \frac{a}{RT} \cdot G^*$$

* $\frac{d\sigma}{dC} > 0$ ($G^* < 0$) $\Rightarrow \Gamma < 0$: Hấp phụ âm
Chất không HĐBM

* $\frac{d\sigma}{dC} < 0$ ($G^* > 0$) $\Rightarrow \Gamma > 0$: Hấp phụ dương
Chất HĐBM

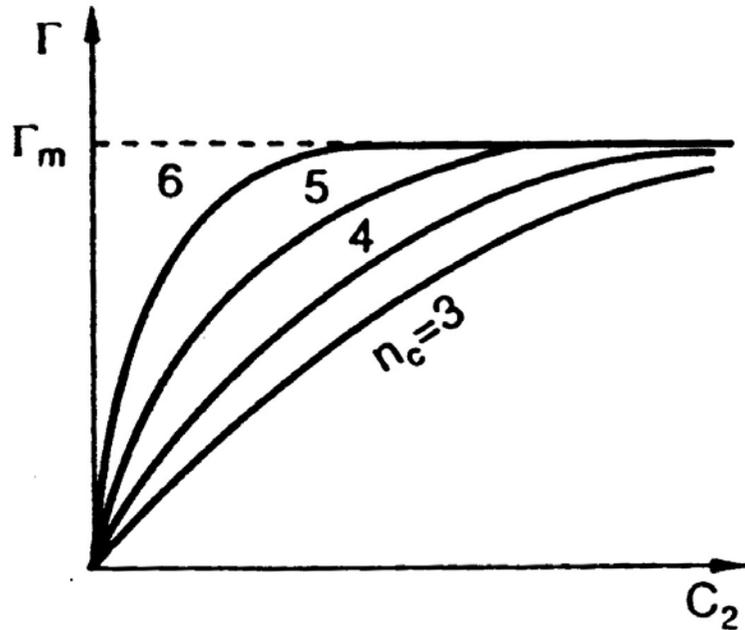
Quy tắc Traube:

Độ hoạt động bề mặt tăng lên 3 - 3,5 lần khi tăng chiều dài mạch cacbon lên thêm một nhóm methylene CH_2 .

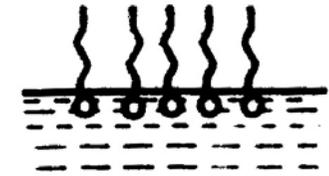


Đường đẳng nhiệt sức căng bề mặt của dãy đồng đẳng chất HDBM – axit hữu cơ

1. HCOOH
2. CH_3COOH
3. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
4. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{COOH}$
5. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COOH}$



a)



b)

- Trong quá trình HP, Γ sẽ tăng đến 1 giá trị giới hạn Γ_m .
- Các phân tử chất HDBM phân bố thành 1 lớp đơn phân tử, tạo thành màng hay bọt.



3. Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir

* Phương trình Sitkopski: $\Delta\sigma = \sigma_0 - \sigma = k.C$ (C nhỏ)

$$\sigma_0 - \sigma = \sigma_0 . B . \ln\left(\frac{C}{A} + 1\right) \quad (C \text{ lớn})$$

1/A: hằng số mao quản riêng \rightarrow phụ thuộc chất HĐBM

B = 0,2 ở 20°C, ít phụ thuộc chất HĐBM.



*** Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir:**

$$\Gamma = -\frac{C}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{dC} = \frac{C}{RT} \cdot B \cdot \sigma_0 \cdot \frac{1}{A+C} = \frac{B \cdot \sigma_0}{RT} \cdot \frac{\frac{1}{A} C}{1 + \frac{1}{A} C} = \frac{k_2 k_1 C}{1 + k_1 C}$$

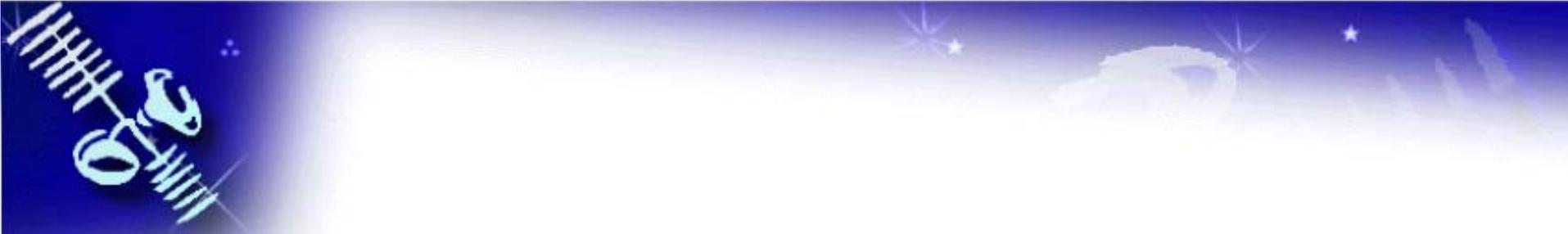
* $k_1 C \ll 1$ ($C \ll A$) : $\Gamma = k_2 k_1 C$

* $k_1 C \gg 1$ ($C \gg A$) : $\Gamma_m = k_2 = \frac{B \sigma_0}{RT}$

$$\Rightarrow \Gamma = \Gamma_m \frac{k_1 C}{1 + k_1 C}$$

Phương pháp xác định Γ_m và k_1 :
→ Vẽ đồ thị

$$\frac{C}{\Gamma} = \frac{C}{\Gamma_m} + \frac{1}{k_1 \cdot \Gamma_m}$$



III. SỰ HẤP PHỤ KHÍ VÀ HƠI TRÊN BỀ MẶT RẮN

HẤP PHỤ VẬT LÝ

HẤP PHỤ HÓA HỌC

+ Lực hấp phụ là lực vật lý: lực Van Der Waals, lực liên kết hydro → tương tác yếu.

+ Lực hấp phụ là lực hóa học: tạo liên kết hóa học.

+ Tạo đa lớp hấp phụ

+ Tạo đơn lớp hấp phụ

+ Khử hấp phụ thuận nghịch

+ Khó khử hấp phụ

+ Không có tính chọn lọc

+ Có tính chọn lọc

+ Nhiệt hấp phụ thường nhỏ: 2 – 6 kcal/mol.

+ Nhiệt hấp phụ tương đối lớn, cỡ nhiệt phản ứng hóa học: > 20 – 22 kcal/mol.

+ Năng lượng hoạt hóa thấp, kéo theo nhiệt độ quá trình thấp.

+ Năng lượng hoạt hóa cao, kéo theo nhiệt độ của quá trình cao.



Các đường biểu diễn hấp phụ:

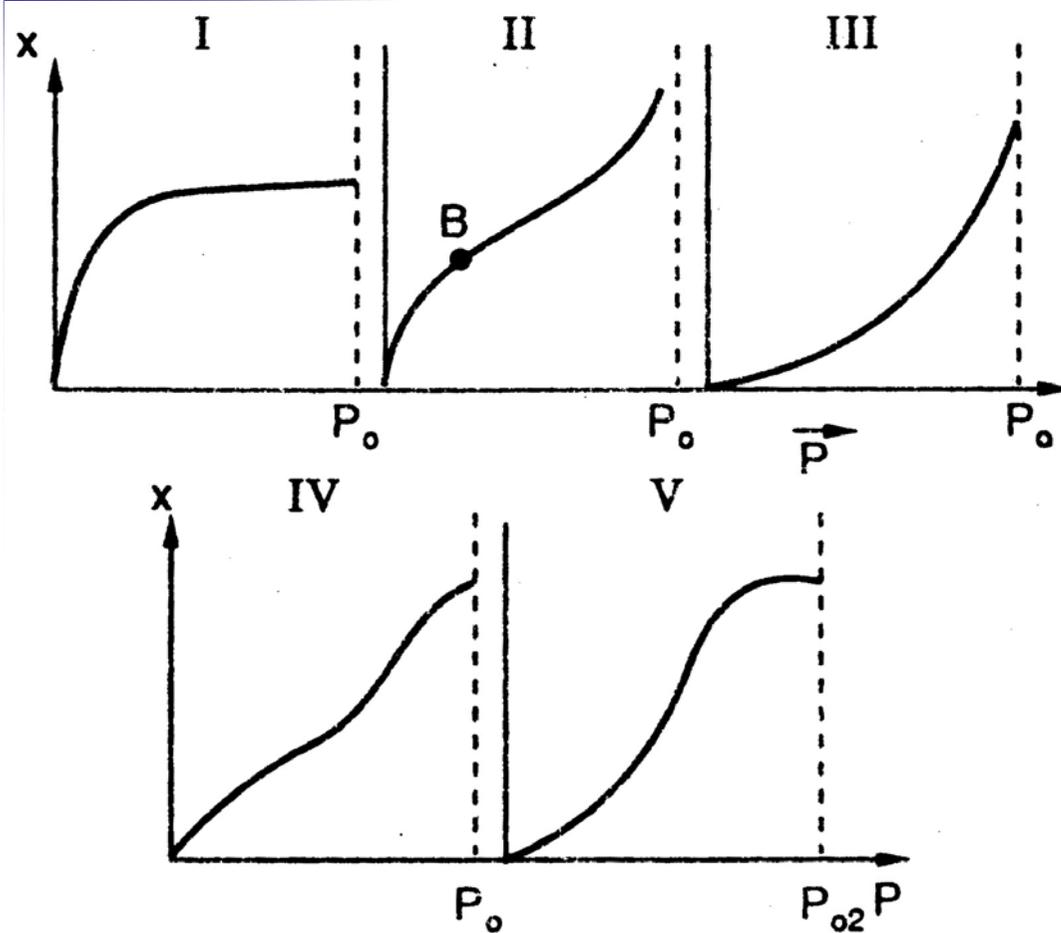
$T = \text{const: } \Gamma = f(C):$ đường đẳng nhiệt hấp phụ.

$P = \text{const: } \Gamma = f(T):$ đường đẳng áp hấp phụ.

$C = \text{const: } \Gamma = f(T):$ đường đẳng lượng hấp phụ.

2. Các phương trình hấp phụ đẳng nhiệt:

Có các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ sau:



I: hấp phụ đơn lớp, tuân theo phương trình Langmuir.

II: Hấp phụ vật lý có tạo thành nhiều lớp phân tử trên bề mặt. Trước điểm B là đơn lớp, qua B là đa lớp.

III: hấp phụ có nhiệt hấp phụ nhỏ hơn hay bằng nhiệt ngưng tụ.

IV, V: tương ứng dạng II & III trong trường hợp có ngưng tụ mao quản, đặc trưng cho hấp phụ trên vật liệu xốp.

a. Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt FREUNDLICH:

$$x = bP^{1/n}$$

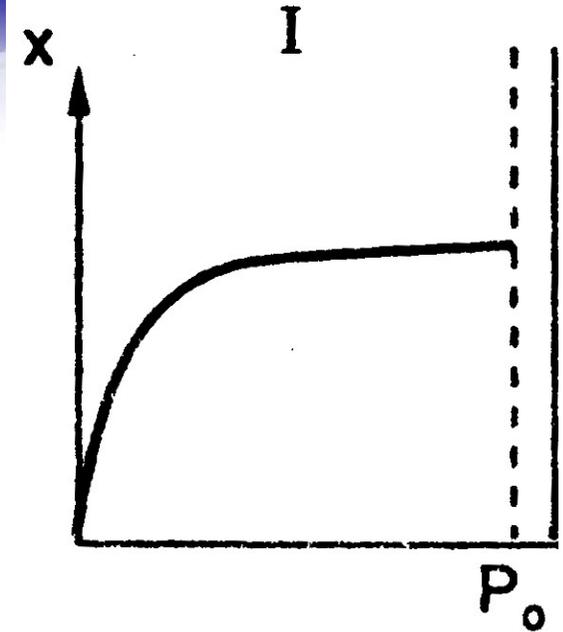
b và **n** là các hằng số.

Với **x**: độ hấp phụ (mol/g).

P: áp suất chất bị hấp phụ sau khi đã đạt cân bằng hấp phụ.

Phạm vi ứng dụng:

- Áp suất trung bình
- Đ/v hấp phụ K/R : sử dụng ở áp suất trung bình
 $1/n = 0,2 - 1$
- Đ/v hấp phụ L/R : (thay P bằng C) $1/n = 0,1 - 0,2$

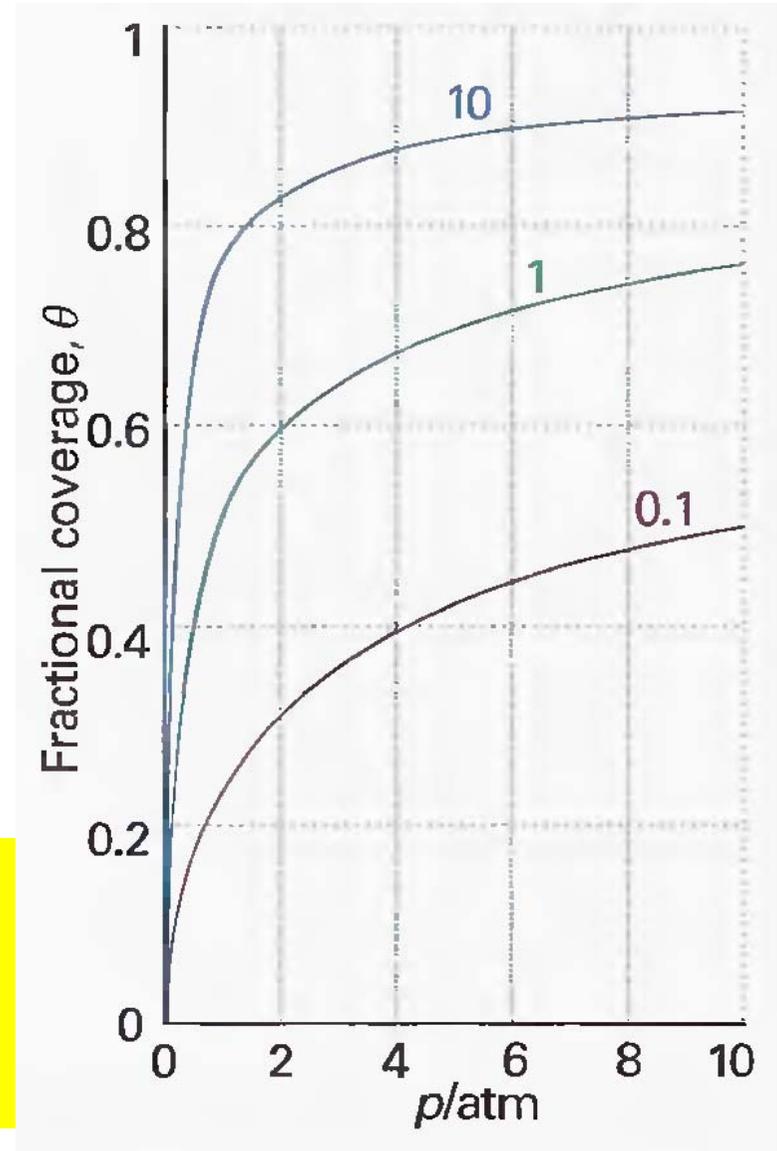


b. Phương trình hấp phụ đơn lớp LANGMUIR:

Giả thiết

- HP là đơn lớp
- E_{HP} đồng nhất (nhiệt HP ở mọi điểm như nhau)
- HP là quá trình thuận nghịch
- Các chất bị HP không tương tác với nhau

Có hạn chế: sai biệt khoảng 30%
Phù hợp với 1 số trường hợp
Là cơ sở cho các thuyết khác



b. Phương trình hấp phụ đơn lớp LANGMUIR:

$$\theta = \frac{x}{x_m} = \frac{v}{v_m} = \frac{Kp}{1 + Kp}$$



$$x = x_m \cdot \frac{Kp}{1 + Kp}$$
$$v = v_m \cdot \frac{Kp}{1 + Kp}$$

Với x_m, v_m (cm³/g): **độ HP tối đa** sao cho HP đơn lớp.

K = const = f(T), không phụ thuộc mức độ che phủ.

Nhận xét:

p nhỏ ($Kp \ll 1$) $\rightarrow x = x_m Kp$

p lớn ($Kp \gg 1$) $\rightarrow x = x_m$

p trung bình $\rightarrow x$ có dạng như pt Freundlich



Xác định bề mặt riêng của chất hấp phụ :

$$S_o = \frac{v_m NA_o}{22400} = x_m NA_o \quad (\text{m}^2/\text{g})$$

Với A_o : diện tích bề mặt chiếm chỗ của phân tử chất bị hấp phụ.

N : số Avogadro.

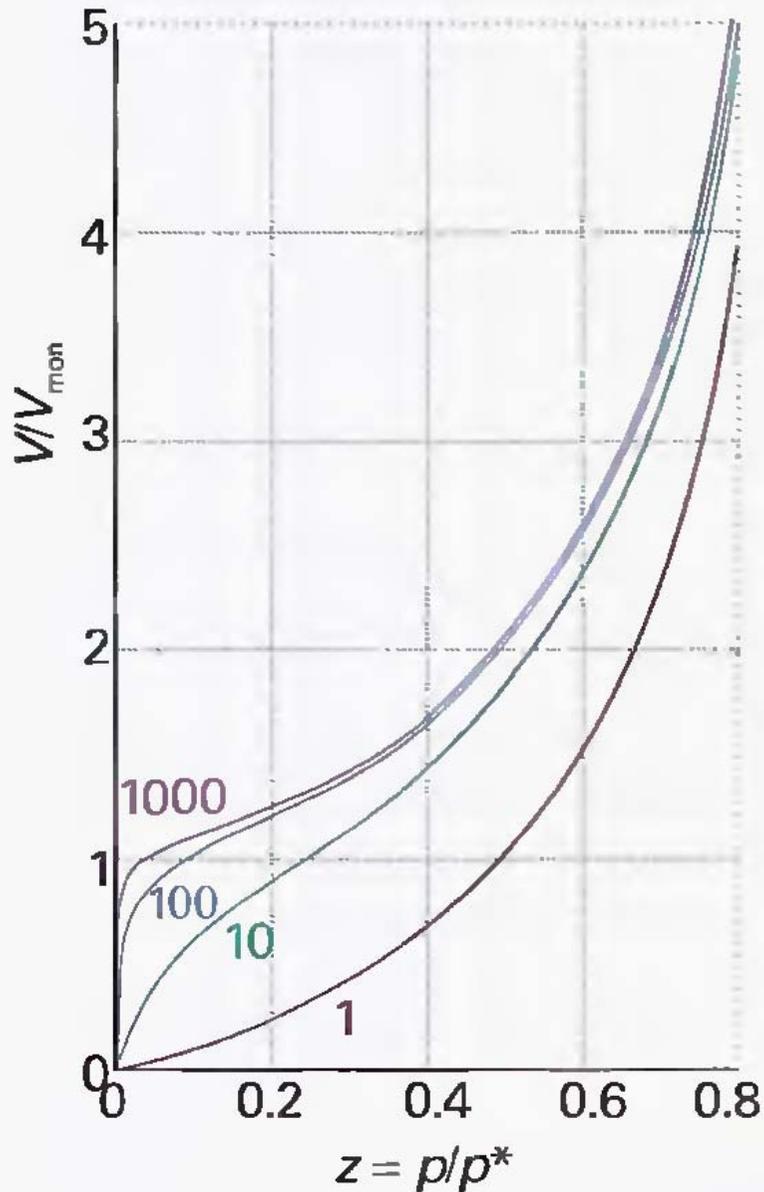


b. Phương trình hấp phụ đa lớp BET:

Brunauer, Emmett, Teller, 1938.

Giả thiết

- HP là đa lớp
- Lực HP chủ yếu là lực Van der Waals
- $E_{HP} \approx E_{\text{ngưng tụ}}$
- Các chất bị HP chỉ tương tác với các phân tử trước và sau nó (không tương tác với phân tử bên cạnh)



Dạng tuyến tính:

$$v = \frac{v_m c \frac{P}{P_0}}{\left(1 - \frac{P}{P_0}\right) \left(1 + c \frac{P}{P_0} - \frac{P}{P_0}\right)}$$

$$v = v_m \frac{cx}{(1-x)[1+(c-1)x]}$$

với $x = \frac{P}{P_0}$ là áp suất tương đối.

$$\frac{P}{v} \cdot \frac{P_0}{P_0 - P} = \frac{P_0}{v_m c} + \frac{c-1}{v_m c} \cdot P$$



Với :

- P_0 :** áp suất hơi bão hòa của khí bị HP.
 v : thể tích khí bị hấp phụ ở áp suất P .
 v_m : thể tích khí bị HP ở áp suất P trong lớp đơn phân tử.
 c : thừa số năng lượng.

$$c = f(T, q_1, q_n) = e^{\frac{-(q_n - q_1)}{RT}}$$

- q_1 :** nhiệt hấp phụ của lớp đơn phân tử đầu tiên.
 q_n : nhiệt ngưng tụ lớp n = nhiệt hóa lỏng khí bị HP

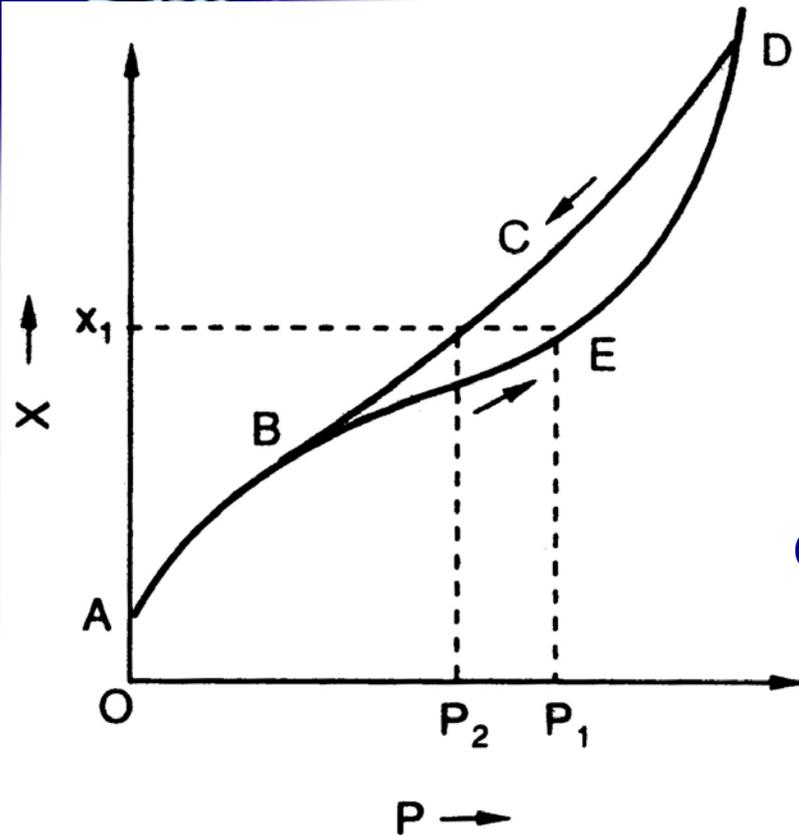


Xác định bề mặt riêng của chất hấp phụ :

$$S_0 = \frac{v_m}{22400} NA_0 \beta$$

β : hệ số đặc trưng cho yếu tố hình học (sắp xếp của các phân tử.
Nếu sắp xếp khít nhau thì $\beta = 1$.

SỰ NGỪNG TỤ MAO QUẢN



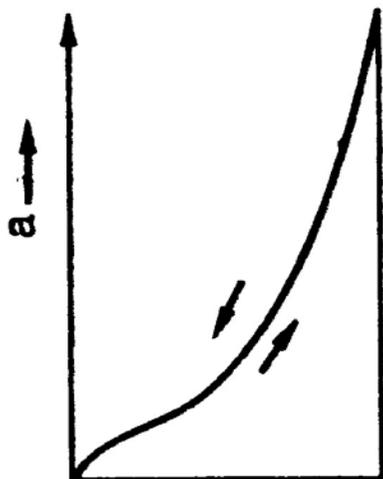
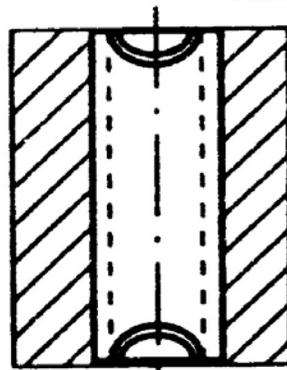
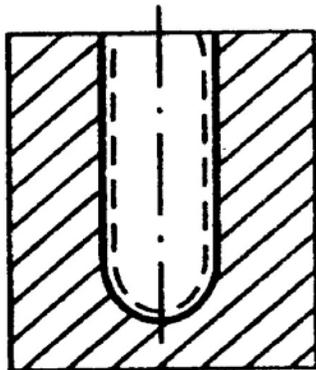
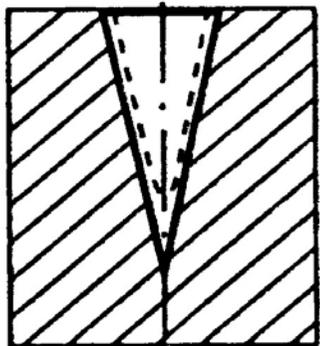
D Là sự ngưng tụ hơi của chất bị HP trong các mao quản của chất HP xảy ra sau sự HP

Hiện tượng:

có vòng trề trên đường HP và giải HP

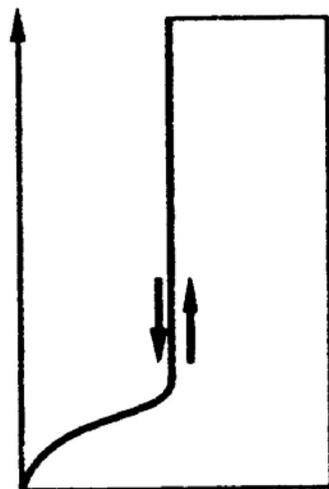
Xảy ra với vật liệu mao quản trung bình

Nguyên nhân: lớp chất bị HP bị dính ướt tạo mặt cong lõm trong mao quản



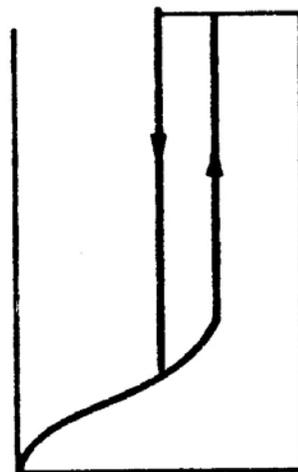
P/P_0 →

a)



P/P_0 →

b)



P/P_0 →

c)



IV. SỰ HẤP PHỤ TRÊN RANH GIỚI LỎNG - RẮN

Hấp phụ LỎNG - RẮN có nhiều điểm giống hấp phụ KHÍ - RẮN.

Điểm khác : Dung môi tương tác với chất bị hấp phụ.
Dung môi có thể bị hấp phụ



1. Hấp phụ các chất không điện ly (HP phân tử)

Độ hấp phụ: x_1 (dung môi) ; x_2 (chất tan)

$$x_2 = \frac{(c_2^o - c_2) \cdot V^o}{m}$$

V^o : thể tích chung của dd (L)

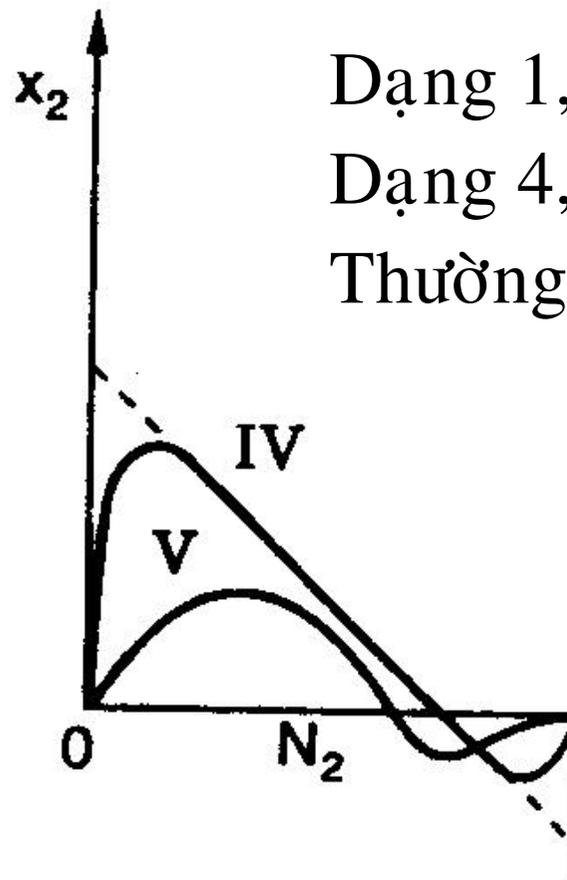
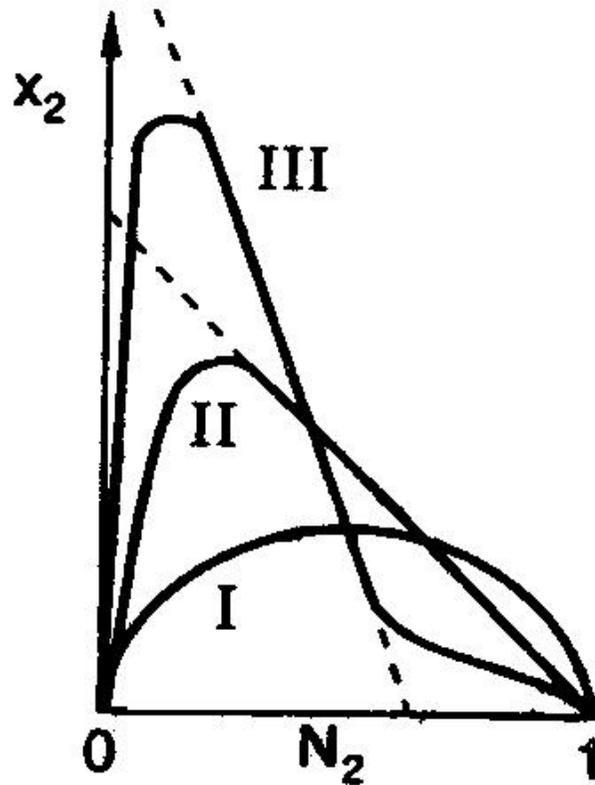
m : lượng chất hấp phụ (g)

c_2^o ; c_2 : nồng độ chất tan trong dd trước & sau HP (mol/L)

Lưu ý: x_i có thể dương hay âm

Đường đẳng nhiệt hấp phụ:

biểu diễn x_2 theo phần mol N_2 của chất tan trong dd



Dạng 1, 2, 3: x_2 dương.

Dạng 4, 5: x_2 đổi dấu

Thường gặp: dạng 1.

Quy luật cơ bản của sự hấp phụ:

Tương tác giữa các phân tử trong pha lỏng có ý nghĩa khá quyết định đ/v khả năng HP

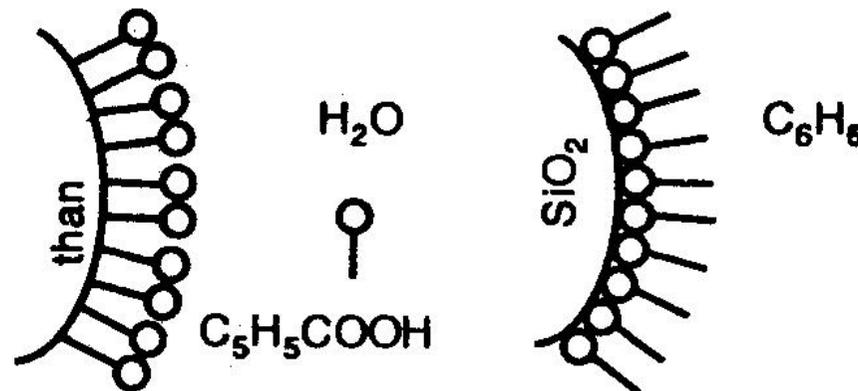
a. Quy tắc phân tử lượng:

Mạch cacbon được kéo dài --> sự HP tăng.

Ngoại lệ: có sự cản trở về không gian (chất HP có lỗ xốp nhỏ) : sự HP giảm khi mạch C tăng

b. Quy tắc phân cực Rebinder: Quá trình HP diễn ra theo chiều hướng làm san bằng sự phân cực giữa các pha.

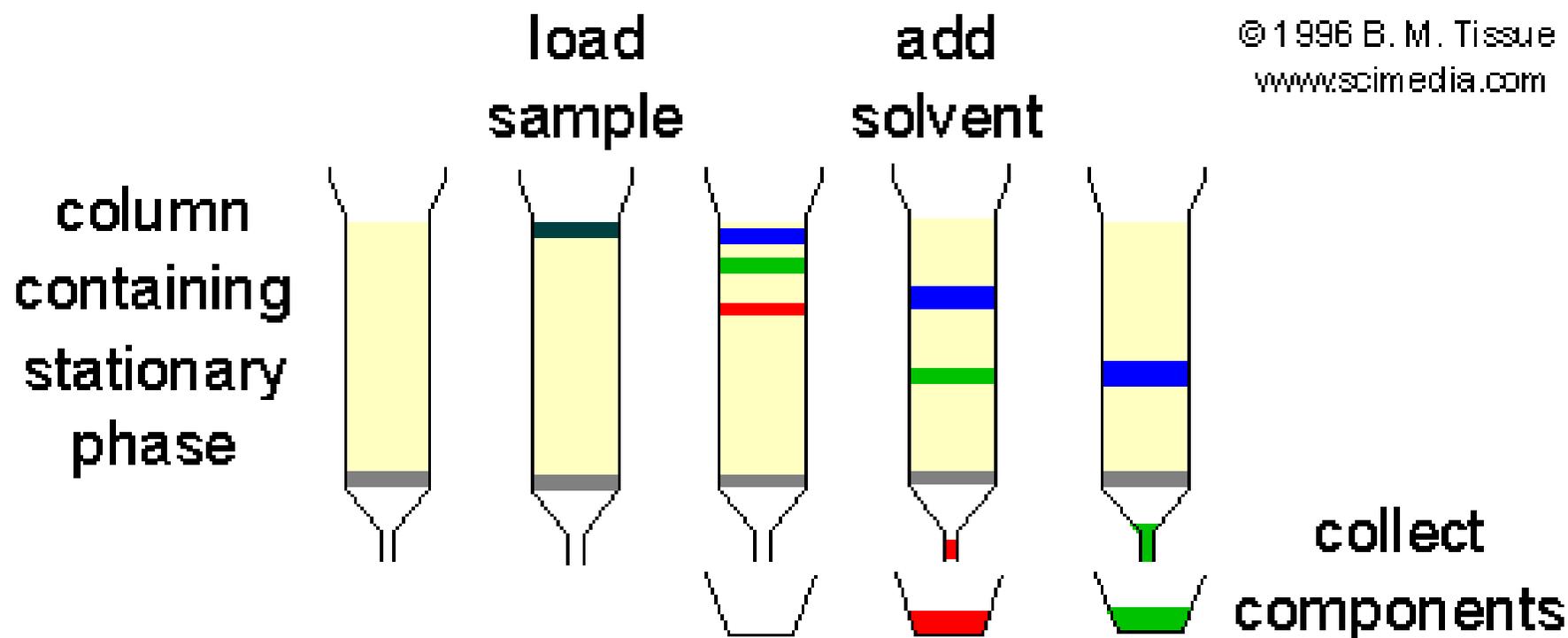
Khác biệt lớn về độ phân cực --> sự HP càng mạnh.



Ứng dụng của HP phân tử

- làm sạch chất lỏng, thu hồi chất quý,
- phân tích hệ nhiều cấu tử

Phương pháp sắc ký





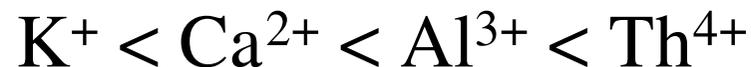
2. Sự hấp phụ các chất điện ly:

Sự HP là sự **phân bố lại điện tích** nhờ động lực là điện trường trên lớp bề mặt.

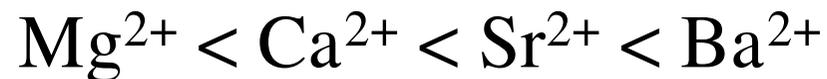
a/ Sự hấp phụ các chất điện ly:

- Chỉ HP ion trái dấu.

- **Điện tích lớn thì dễ bị HP**



- Đối với các ion cùng điện tích: **bán kính lớn thì dễ bị HP**



HP ưu tiên: ion bị HP có trong mạng tinh thể, hoặc giống ion trong mạng TT.



b/ Sự trao đổi ion: (HP trao đổi)

Chất HP: - HP một lượng ion từ dd
- đẩy ra 1 lượng tương đương về điện.

Đặc điểm:

- Có độ chọn lọc cao.
- Quá trình có thể không thuận nghịch.
- Sự trao đổi ion diễn ra chậm.
- Có thể làm thay đổi pH của dd (khi trao đổi H^+ hoặc OH^-)